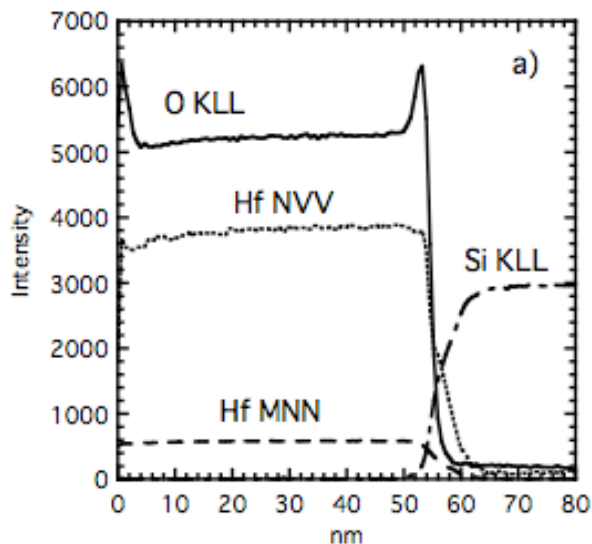


研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO₂/Si基板の分析” に掲載されている Fig.8
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

DOI

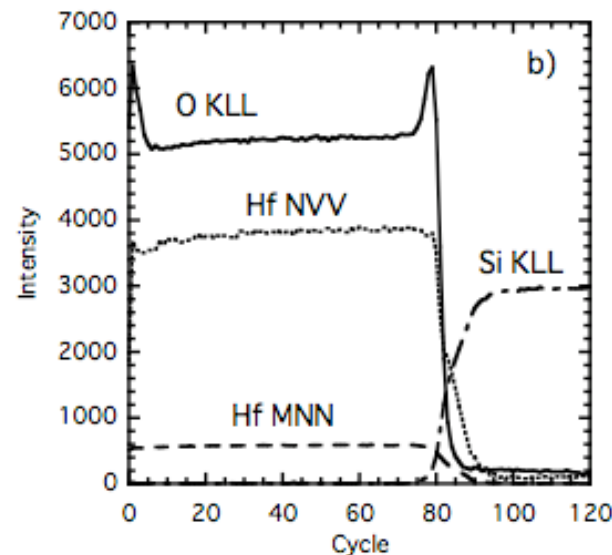
<https://doi.org/10.1384/jsa.24.192>

荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



AES depth profile of the HfO₂:55nm/Si substrate using the ultra low angle incident beam method with the argon ion energy of 3.0 keV.

Horizontal axis is nm.

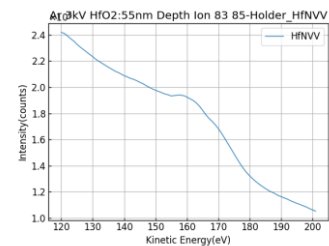


AES depth profile of the HfO₂:55nm/Si substrate using the ultra low angle incident beam method with the argon ion energy of 3.0 keV.

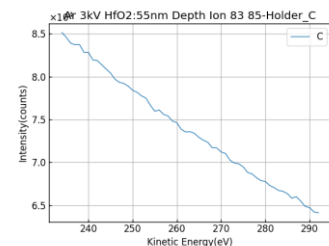
Horizontal axis is cycles.

- a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig.8 に相当し, 横軸は nm である.
b) は横軸を測定回数で表したものであり, 横軸を nm に変換する前のプロファイルである Raw data ファイルは, b) に対応している.

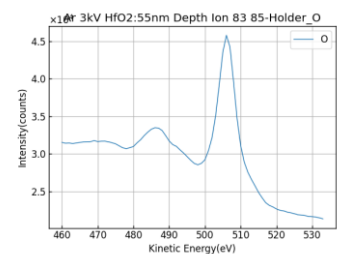
Energy(ev)	Intensity		
120	188650	177	106615
121	187820	178	105463
122	186298	179	104290
123	184484	180	103389
124	182582	181	102392
125	180862	182	101222
126	179211	183	100307
127	177534	184	99307
128	175964	185	98566
129	174514	186	97610
130	173022	187	97037
131	171683	188	96372
132	170141	189	95667
133	168531	190	94830
134	167381	191	94253
135	166326	192	93614
136	164980	193	92959
137	163769	194	92355
138	162487	195	91532
139	161378	196	90847
140	159970	197	90283
141	158804	198	89731
142	157468	199	89058
143	156146	200	88372
144	154656	201	88010
145	153312		
146	152006		
147	150878		
148	149896		
149	148720		
150	147338		
151	146408		
152	145637		
153	145010		
154	144778		
155	144635		
156	143985		
157	143064		
158	141578		
159	140136		
160	138474		
161	136603		
162	134203		
163	132067		
164	130449		
165	129185		
166	127984		
167	126335		
168	124587		
169	122256		
170	119991		
171	117360		
172	114976		
173	112485		
174	110764		
175	109076		
176	107774		



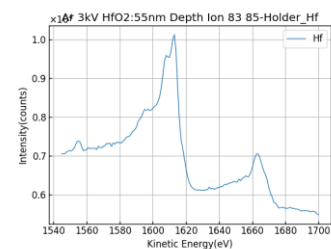
Raw data of Hf-NV



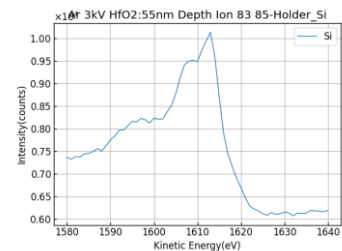
Raw data of C



Raw data of O



Raw data of Hf



Raw data of Si

Hf-NV Raw dataファイルの構造

Raw data の図化